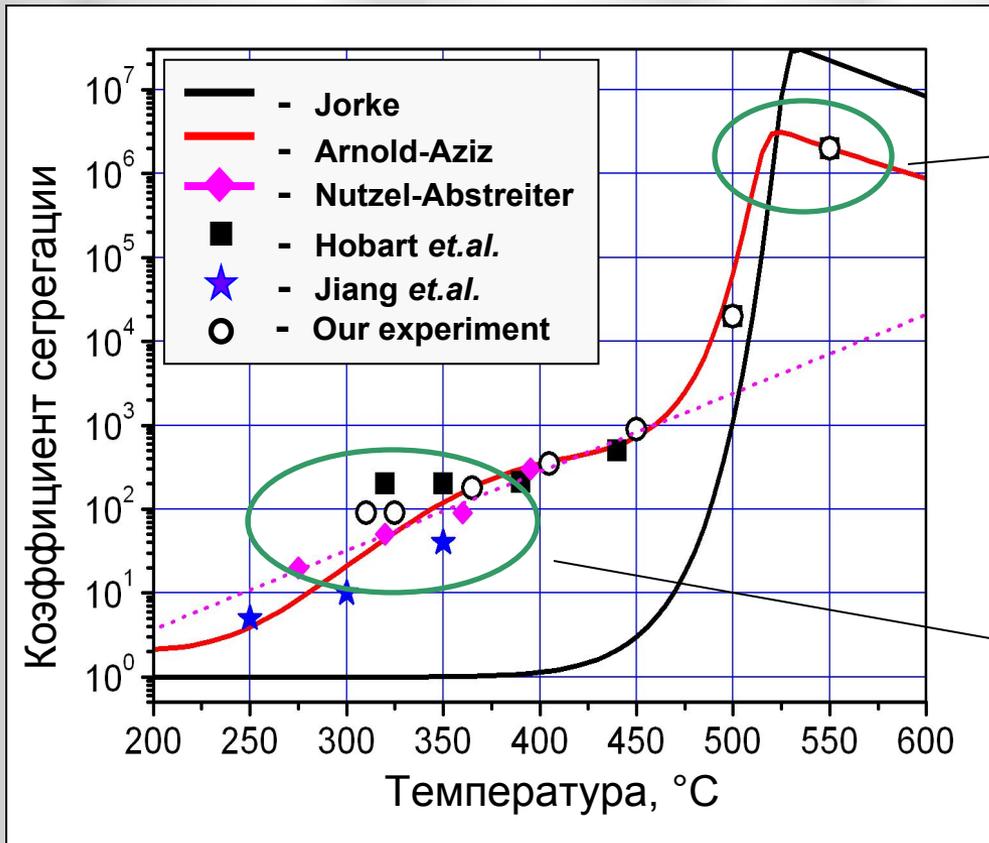


# Используемый нами метод изготовления Si:Sb структур



$r \sim 10^6$

различие более чем на 4 порядка  
в диапазоне  $300 \leq T_p \leq 550^\circ\text{C}$  !

$r \sim 10^2$

Для создания:

- 1) Высоколегированных слоев - используются низкие  $T$  роста
- 2) Резкого изменения профиля концентрации – варьирование  $T$  роста в диапазоне  $300 \div 550^\circ\text{C}$
- 3) Нелегированных слоев – рост при высоких  $T$  (т.е. при максимальной сегрегации)